УДК 539.1.08

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КОНВЕРТОРА НА ОТКЛИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО СПЕКТРОМЕТРА

В.А. Басков

Представлены результаты экспериментальных исследований отклика электромагнитного спектрометра с конвертором из ориентированного вдоль оси (111) кристалла вольфрама при энергии электронов 26,28 и 31 ГэВ. Обнаружено, что отношение разности положений максимума каскадной кривой при разориентированном и ориентированном конверторе к разности энерговыделения в максимуме каскадной кривой является величиной постоянной при данной энергии электронов, типе и толщине конвертора и не зависит от температуры конвертора.

Ключевые слова: ориентированный кристалл, электромагнитный спектрометр, отклик спектрометра, каскадная кривая, энергетическая зависимость.

Область взаимодействия электронов, позитронов и γ -квантов при энергиях в десятки и сотни ГэВ с кристаллом, в которой когерентный характер взаимодействия частиц с полем оси (плоскости) кристалла приводит к значительному росту сечений всех электродинамических процессов, получила название область "*постоянного сильного поля*" (ПСП). Область ПСП формируется при углах входа частиц в кристалл $\Theta \ll \Theta_{\rm CSF} = V/mc^2$ (Θ – угол между импульсом γ -кванта, электрона или позитрона и осью (плоскостью) кристалла; V – масштаб потенциала оси или плоскости; m – масса электрона; c – скорость света) [1].

Электромагнитные ливни, образованные электронами, позитронами и γ -квантами при взаимодействии с кристаллом в области ПСП (*аномальные* ливни) отличаются от ливней в аморфном веществе (*стандартные* ливни). Отличие ливней в ориентированных кристаллах (кристалл считается ориентированным при $\Theta \leq \Theta_{\rm CSF}$; кристалл считается разориентированным при $\Theta \gg \Theta_{\rm CSF}$) проявляется во всех характеристиках ливней: множестве заряженных и незаряженных частиц ливня, в зависимостях энергии

ФИАН, 119991 Россия, Москва, Ленинский пр-т., 53; e-mail: baskov@x4u.lebedev.ru.

частиц от глубины развития ливня; в наличии ориентационной зависимости; в уменьшении радиационной длины кристалла; в наличии температурной зависимости развития ливня и т.д. *Аномальный* ливень, выходящий из кристалла и продолжающийся развиваться в спектрометре, вызывает отклик спектрометра, отличный от отклика на *стандартный* ливень [2–4].

В данной работе представлены результаты исследований влияния разориентированного и ориентированного вольфрамового конвертора на отклик электромагнитного спектрометра, регистрирующего ливни от электронов.

Работа выполнена на установке "Каскад" на электронном канале 2В ускорителя ИФВЭ в рамках программы изучения эффектов квантовой электродинамики в сильных полях ориентированных кристаллов, одной из целей которой было изучение аномальных электромагнитных ливней.

В работе использовались кристаллы вольфрама толщинами 1.0, 2.7, 5.8, 8.4 мм $(X_0 = 3.5 \text{ мм}, X_0 - \text{радиационная длина})$. Ориентация кристаллов осуществлялась вдоль оси (111). Разориентированным считался кристалл, ось которого была повернута относительно оси пучка электронов на угол $\Theta = 20 - 30$ мрад. Мозаичность кристаллов составляла $\Delta \Theta_W \approx 1$ мрад. Исследования проводились как с кристаллами, находящимися при комнатной температуре $T_1 = 293$ K, так и с кристаллами, охлажденными до температуры жидкого азота $T_2 = 77$ K. В эксперименте использовался пучок электронов с энергиями E = 26, 28 и 31 ГэВ.

Ливень, выходивший из кристалла, продолжал развиваться в составном черенковском ливневом спектрометре (СЧЛС), состоящем из 10 независимых светоизолированных счетчиков (радиаторов) из свинцового стекла ТФ-1 размером 100×100 мм² и толщиной $1X_0$. Для сбора оставшейся части ливня за СЧЛС находился черенковский спектрометр (ЧС) толщиной $15X_0$ [3, 5, 6].

Поведение положения максимума каскадной кривой $t_{\rm max}$ при развитии электромагнитного ливня от энергии электронов в СЧЛС в отсутствие вольфрамового конвертора перед ним описывается выражением [7]:

$$t_{\max} = \ln\left(E/E_c\right) - c,\tag{1}$$

где E – энергия электронов в МэВ, $E_c = 15$ МэВ – критическая энергия черенковского стекла ТФ-1; c = 0.5.

Если поместить разориентированный вольфрамовый конвертор перед СЧЛС, то каскадная кривая сдвинется в сторону начала развития ливня в среднем на величину толщины кристаллического конвертора t_w [8]:

$$t_{\max} = \ln\left(E/E_c\right) - c - t_w.$$
(2)

При ориентации кристалла вследствие взаимодействия электрона с сильным полем кристаллографической оси меняется характер развития ливня, что приводит к уменьшению радиационной длины кристалла (X'_0) и увеличению его эффективной толщины $t_{w\,\text{eff}}$ (t_{eff} – эффективная толщина кристалла, на которой происходит наиболее эффективное взаимодействие частиц с кристаллом) [8]:

$$t_{\max} = \ln\left(E/E_c\right) - c - t_{w\,\text{eff}},\tag{3}$$

где $t_{w\,\text{eff}} = t_w + \Delta t$, а $\Delta t = t_{\text{max}\,\text{p}} - t_{\text{max}\,\text{o}}$ является "добавкой" к толщине кристалла за счет ориентации ($t_{\text{max}\,\text{p}}$ и $t_{\text{max}\,\text{o}}$ – положение максимума каскадной кривой при разориентированном и ориентированном кристалле, соответственно).

Охлаждение ориентированного кристалла ведет к сокращению амплитуды тепловых колебаний атомов кристалла и увеличению потенциальной ямы кристаллографической оси, что в свою очередь ведет к возрастанию сечений электродинамических процессов, ещё большей сдвижке каскадной кривой к началу развития ливней или увеличению Δt [3, 8]:

$$t_{\rm max} = \ln \left(E/E_c \right) - c - t_{w\,\rm eff} - \Delta t_{\rm temp},\tag{4}$$

где $\Delta t_{\text{temp}} = t(T_1)_{\text{maxo}} - t(T_2)_{\text{maxo}}$ является "добавкой" к толщине кристалла за счет изменения температуры с T_1 до T_2 уже ориентированного кристалла (индекс "о" – кристалл ориентирован).

Развитие ливня в аморфном веществе спектрометра без кристаллического конвертора и с конвертором можно представить в виде зависимости положения максимума развития электромагнитного ливня ($t_{\rm max}$) в спектрометре (СЧЛС) от энерговыделения в максимуме развития ($\Delta E_{\rm max}$). Данная зависимость для разных энергий электронов, толщин разориентированных и ориентированных кристаллов представлена на рис. 1 [9].

Из рис. 1 видно, что зависимость положения максимума развития ливня t_{max} и энерговыделение в максимуме развития ливня ΔE_{max} для разориентированного и ориентированного кристалла окажутся разными. Действительно, при разориентированном конверторе для каждой фиксированной энергии электронов E зависимость t_{max} от ΔE_{max} , как и в случае зависимости t_{max} от E, является прямой, параллельной оси t_{max} (зависимость показана штрихпунктирной линией). Если кристалл ориентирован, то меняются



Рис. 1: Зависимость положения максимума развития электромагнитного ливня t_{\max} в СЧЛС с кристаллическим вольфрамовым конвертором от энерговыделения в максимуме развития ливня $\Delta E_{\max}(\times, \bullet, \bigcirc, \blacktriangle, \circlearrowright, \nabla, \otimes, \diamondsuit, \diamondsuit, \neg = эксперимент; \blacksquare, \Box, + - оцен$ $ка [10, 11]; <math>\times$ - спектрометр без кристалла ($t_w = 0$); $\bullet, \blacksquare, \blacktriangle, \lor, \diamondsuit, + -$ кристалл разориентирован; $\nabla, \bigcirc, \Box, \otimes, \measuredangle, \diamondsuit = k$ ристалл ориентирован вдоль оси $\langle 111 \rangle$; $\bullet, \bigcirc, \blacksquare, \Box, +$ $t_w = 1.0 \text{ мм}; \blacktriangle, \bigtriangleup - t_w = 2.7 \text{ мм}; \lor, \nabla - t_w = 5.8 \text{ мм}; \diamondsuit, \diamondsuit - t_w = 8.4 \text{ мм};$ $\bullet, \bigcirc, \blacksquare, \Box, \bigstar, \circlearrowright, \lor, \bigtriangledown, \diamondsuit, \diamondsuit, \frown - T = 293 K; \boxtimes - T = 77 K; + - T_d \sim 980K$).

поведение t_{max} и ΔE_{max} . В этом случае при данной энергии электронов, толщине и температуре кристалла отношение $\Delta t_{\text{max}}/\Delta E_{\text{max}} = \text{const} (\Delta t_{\text{max}} = t_{\text{max p}} - t_{\text{max o}}; \Delta E_{\text{max}} = E_{\text{max o}} - E_{\text{max p}}; t_{\text{max p(o)}}$ и $E_{\text{max o(p)}}$ – положение максимума и энерговыделение в максимуме развития ливня при разориентированном (p) и ориентированном (o) кристалле, соответственно) (зависимость показана штриховой линией). Из рис. 1 также видно, что отношение $\Delta t_{\text{max}}/\Delta E_{\text{max}}$ не меняется при изменении температуры с $T_1 = 293$ K до $T_2 = 77$ K и при увеличении температуры $T_1 = 293$ K до $T_d (T_d$ – температура, при которой происходит полная дезориентация кристалла, то есть кристалл невозможно сориентировать (оценка показывает, что $T_d \sim 980$ K [10])).

Таким образом, можно утверждать, что для каждой энергии электронов, типа и толщины разориентированного и ориентированного кристалла, диапазона температур от $T = T_d$ до $T \ge 77$ K существует присущее только этому набору параметров отношение $\Delta t_{\max}/\Delta E_{\max} = \text{const.}$

Автор выражает благодарность [Е.И. Тамму] и Е.И. Малиновскому за поддержку работы; В.И. Сергиенко за научное руководство; В.В. Ким, И.В. Конорову, В.В. Полянскому, В.А. Хабло, сотрудникам НИЯУ МИФИ Б.И. Лучкову и В.Ю. Тугаенко, сотруднику ИФВЭ В.А. Маишееву и сотрудникам Харьковского физико-технического института (Украина) под руководством Л.Я. Колесникова за помощь в работе.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] U. I. Uggerhoj, Reviews of Modern Physics 77, 1131 (2005).
- [2] В. А. Басков, Краткие сообщения по физике ФИАН **39**(10), 28 (2012).
- [3] В. А. Басков, Краткие сообщения по физике ФИАН **40**(5), 3 (2013).
- [4] В. А. Басков, Краткие сообщения по физике ФИАН **41**(4), 21 (2014).
- [5] В. А. Басков, А. С. Белоусов, В. В. Ким и др., ПТЭ 5, 66 (2011).
- [6] В. А. Басков, Краткие сообщения по физике ФИАН **39**(8), 16 (2012).
- [7] А. В. Калиновский, Н. В. Мохов, Ю. П. Никитин, *Прохождение частиц высоких* энергий через вещество (М., Энергоатомиздат, 1985).
- [8] В. А. Басков, Краткие сообщения по физике ФИАН 41(3), 32 (2014).
- [9] В. А. Басков, Препринт ФИАН № 9 (Москва, ФИАН, 2013).
- [10] В. А. Басков, в: Сессия-конференция Отделения Ядерной физики РАН "Физика фундаментальных взаимодействий", 12.11-16.11.2012 г., НИЯУ МИФИ; (http://www.icssnp.mephi.ru/content/file/section7/7_18_baskov.pdf).
- [11] В. А. Басков, Краткие сообщения по физике ФИАН **40**(8), 43 (2013).

Поступила в редакцию 26 января 2015 г.